

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成20年8月14日 (2008.8.14)

【公開番号】特開2007-56346(P2007-56346A)

【公開日】平成19年3月8日 (2007.3.8)

【年通号数】公開・登録公報2007-009

【出願番号】特願2005-245612(P2005-245612)

【国際特許分類】

C 2 3 C 18/34 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 21/288 (2006.01)

H 0 5 K 1/09 (2006.01)

H 0 5 K 3/18 (2006.01)

H 0 5 K 3/24 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 18/34

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

H 0 1 L 21/288 E

H 0 5 K 1/09 C

H 0 5 K 3/18 J

H 0 5 K 3/24 A

【手続補正書】

【提出日】平成20年6月30日 (2008.6.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

酢酸ニッケルを主成分とする金属供給源としてのニッケル塩と、還元剤としてのヒドラジンと、錯化剤としての E D T A および乳酸と、p H 緩衝剤としてのホウ酸とからなり、前記酢酸ニッケルを 3 0 . 3 ~ 3 5 . 4 g / L、前記ヒドラジンを 2 4 . 3 ~ 4 8 . 6 m l / L、前記乳酸を 4 9 . 3 ~ 6 1 . 6 m l / L、前記 E D T A を 9 . 5 ~ 1 9 g / L、前記ホウ酸を 2 4 . 8 ~ 3 7 . 2 g / L の浴組成とした無電解ニッケルめっき浴。

【請求項 2】

請求項 1 記載の無電解ニッケルめっき浴を用いて、絶縁基板上の銅電極上に無電解ニッケルめっき皮膜を形成する無電解めっき方法。